

## 연수 제안서

<b>연구 분야</b>	IV족 및 III-V족 반도체 광전소자 연구
<b>연구 과제명</b>	광자기반 양자 기술향 능동 소자 응용을 위한 Si기반 나노소재, 산화물소재, 3-5족 반도체 소재개발
<b>연수 제안 업무</b>	IV족 및 III-V족 반도체를 이용한 광전소자의 설계/공정/측정에 관한 연구
<p><b>(연수 내용)</b></p> <p>- 연수기간 : 입원 후 1년 (실적 등에 따라 추가 연장 가능)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p>양자 기술을 위해서는 III-V족 및 IV족 반도체를 이용한 광전소자의 연구가 필수적임. 특히 양자집적소자를 실현할 IV족 및 III-V족 전자소자와 광소자 기술을 개발하기 위해, 소자 디자인, 소자 공정, 소자 측정을 전반적으로 수행할 예정.</p> <p>구체적으로는 다음 중 하나 이상의 연구에 투입되어 연구를 진행할 예정</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 고성능 III-V족 수광소자에 관한 연구</li> <li>2. 고성능 III-V족 RF 소자에 관한 연구</li> <li>3. III-V족 소자와 IV족 소자의 이종집적 소자에 관한 연구</li> </ol>	
<p><b>소속 부 서 : 광전소재연구단</b></p> <p><b>연수 책임자 : 한 재 훈</b></p>	